

大見研究室 和文 論文リスト

1991 年

- 258(C) 野仲徹、小野寺政信、堀越基伸、大見忠弘、「高品質ULSI製造のための脱ガスの無いレジストプロセス」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.26-37、1991年1月。
- 259-1(F) 牛越健一、山田章、杉澤政宣、宝月章彦、今岡孝之、杉山勇、去来川辰彦、大見忠弘、「GOLD EP製超々純水装置テスト報告」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.57-62、1991年1月。
- 259-2(M) 大見忠弘、「超クリーン化推進技術が理想的な素子特性に結び付き狙い通りのプロセス実現にメドール」、日経マイクロデバイス1991年1月号、(日経BP社)、pp.110-113、1991年1月。
- 260(C) 青木保雄、青山真太郎、大見忠弘、「清浄化表面と金属成膜」、第23回VLSI FORUM—シリコン自然酸化膜の生成機構と除去法—、(株)プレスジャーナル 調査部)、pp.35-45、1991年3月。
- 261(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.9 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 9、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1、1991年3月。
- 262(C) 作佐部健一、林正己、森川洋輔、杉山和久、森木一紀、森田瑞穂、大見忠弘、服部健雄、「角度分解XPSによる薄いシリコン熱酸化膜の構造解析」、第38回応用物理学関係連合講演会講演予稿集No. 2、((社)応用物理学会)、29a-SY-10、pp.662、1991年3月。
- 263(C) 寺田直純、芳賀敬、杉山和久、森木一紀、森田瑞穂、大見忠弘、藤沢正美、服部健雄、「真空紫外域におけるシリコン熱酸化膜の光吸収」、第38回応用物理学関係連合講演会講演予稿集No. 2、((社)応用物理学会)、29a-SY-11、pp.663、1991年3月。
- 264(C) 林正己、作佐部健一、鈴木康介、杉山和久、森木一紀、寺本章伸、牧原康二、森田瑞穂、大見忠弘、服部健雄、「前処理過程が極薄熱酸化膜構造に及ぼす影響」、第38回応用物理学関係連合講演会講演予稿集No. 2、((社)応用物理学会)、29a-SY-12、pp.663、1991年3月。
- 265(C) 藪本周邦、斎藤和之、森田瑞穂、大見忠弘、「洗浄シリコン表面の物性とその解析」、1991年電子情報通信学会春季全国大会講演論文集、分冊5エレクトロニクス、((社)電子情報通信学会)、SC-9-1、pp.5-331-5-332、1991年3月。
- 266-1(C) 室田淳一、松浦孝、加藤学、植竹宏明、大見忠弘、小野昭一、「反応雰囲気の高清浄化による選択成長/エッチング」、1991年電子情報通信学会春季全国大会講演論文集、分冊5エレクトロニクス、((社)電子情報通信学会)、SC-9-5、pp.5-339-5-340、1991年3月。
- 266-2(B) 大見忠弘、森田瑞穂、「薄膜形成技術—超清浄・超ドライ酸化膜形成の重要性と将来展望—」、MARUZEN Advanced Technology—材料工学編—ULSIプロセスの基礎技術、(丸善(株))、pp.139-169、1991年3月。
- 267(C) 稲葉仁、阪田総一郎、九嶋哲也、吉田隆紀、岡田孝夫、相合征一郎、大見忠弘、「スピンドライヤー乾燥におけるウェハ帯電の防止」、第10回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会予稿集、((社)日本空気清浄協会)、pp.271-278、1991年4月。
- 268(B) 大見忠弘、「スーパークリーンルームシステム」、応用物理 Vol.60、No.4、((社)応用物理学会)、pp.379-380、1991年4月。
- 269(C) 宮下雅之、大見忠弘、「シリコン表面マイクロラフネスのウェットプロセス依存性」、SEMI STEP/Microroughness '91、(SEMI JAPAN)、1991年4月。
- 270(M) 大見忠弘、「研究会の新たな胎動に向けて—併せてオールメタル酸化不動態処理配管技術の誕生を祝う—」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1991年4月。

- 231-2(F) 中村雅一、大見忠弘、杉山和彦、水口泰光、川田幸司、大倉淳伸、「超高純度ガス供給系トータルシステム」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.4-19、1991年4月。
- 232-2(F) 川田幸司、中村雅一、杉山和彦、水口泰光、大倉淳伸、佐々木真、桑原英司、大見忠弘、「熱酸化不動態処理」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.20-30、1991年4月。
- 233-2(F) 内沢修、菅野洋一、大川宏、朝倉利博、大見忠弘、「オールメタルバルブ」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.37-47、1991年4月。
- 246-2(F) 伊藤一男、大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーを適用したオールメタルゲートバルブ」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.69-74、1991年4月。
- 247-2(F) 林雄造、大見忠弘、「無摺動ゲートバルブの開発」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.75-82、1991年4月。
- 271(M) 佐藤賢一、中村雅一、大見忠弘、「半導体製造におけるメタルフィルタの利用」、金属臨時増刊号、先端膜技術—その基礎と応用—Part II—、(株アグネ)、pp.104-109、1991年4月。
- 272(C) 宮下雅之、板野充司、今岡孝之、川辺一郎、大見忠弘、「シリコン表面マイクロラフネス制御による酸化膜耐圧の向上」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91 No.16、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-3、pp.13-18、1991年4月。
- 273(C) 大倉淳伸、奥秀彦、松本光市、大見忠弘、「表面マイクロラフネスおよび界面汚染を低減する減圧CVDエピタキシャルシリコン成長技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91 No.16、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-4、pp.19-24、1991年4月。
- 274(C) 青木保雄、青山真太郎、植竹宏明、森塚宏平、大見忠弘、「高品質スパッタ成膜のための低エネルギーイオン照射表面クリーニング技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91 No.16、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-5、pp.25-30、1991年4月。
- 275(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.10」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 10、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1991年5月。
- 276(C) 大見忠弘、「ウェハ表面洗浄と酸化膜特性」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 10、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.5-19、1991年5月。
- 277(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.11 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 11、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1991年6月。
- 278(C) フレデリック W. カーン Jr.、板野充司、川辺一郎、宮下雅之、大見忠弘、「ウェハ表面の極微量金属吸着機構」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 11、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.23-37、1991年6月。(英文)
- 279(C) 今岡孝之、杉山勇、毛塚健彦、大見忠弘、「液体・固体界面の金属不純物偏析」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 11、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.41-80、1991年6月。
- 280(C) 川辺一郎、菊山裕久、脇雅秀、坂喜代憲、藪根辰弘、三木正博、宮下雅之、高野順、大見忠弘、「バッファードフッ酸によるシリコン酸化のエッチング機構」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 11、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.83-93、1991年6月。
- 281(C) 佐藤賢一、フレデリック W. カーン Jr.、大見忠弘、山崎康夫、佐藤源一、加地利光、堀木泰之、「熱燐酸によるシリコン窒化膜エッチングのメカニズム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 11、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.97-107、1991年6月。
- 282(C) 加地利光、大見忠弘、「アドヴァンスドウェハクリーニング」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 11、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.111-136、1991年6月。

- 283(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.12 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-4、1991年6月。
- 284(C) 川田幸司、大木厚志、中村雅一、大見忠弘、「ステンレス表面に対する水分の吸着-脱離」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.7-22、1991年6月。
- 285(C) 大木厚志、川田幸司、中村雅一、大見忠弘、「SiおよびSiO₂表面の水分の吸着・脱離」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.25-45、1991年6月。
- 286(C) 羽坂智、山下毅雄、名取巖、大見忠弘、「特殊ガスプラズマのイオン密度とエネルギー」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.63-85、1991年6月。
- 287(C) 山下毅雄、羽坂智、名取巖、大見忠弘、「特殊ガスプラズマによるダメージと汚染」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 12、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.89-103、1991年6月。
- 288(C) 大見忠弘、宮下雅之、三木正博、「無水HFガスによるSi表面クリーニング」、結晶加工と評価技術第145委員会、第55回研究会資料、主題: Siウェーハのクリーニングと自然酸化、(日本学術振興会)、pp.17-23、1991年6月。
- 289(C) 中村雅一、川田幸司、大木厚志、日置晃、平尾圭志、大見忠弘、「特殊材料ガス中の微量水分測」、第9回大阪酸素半導体セミナー-ULSI製造におけるUCTの責務-講演集、(大阪酸素工業株)、pp.5-12、1991年6月。
- 290-1(C) 大見忠弘、「高性能分析評価技術の重要性」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 13、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-6、1991年7月。
- 291-1(C) 大見忠弘、宮下雅之、寺本章伸、牧原康二、都賀智仁、「半導体表面マイクロラフネスのデバイス特性への影響」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 13、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.51-70、1991年7月。
- 292-1(C) 三木正博、米沢勲、渡辺明、村瀬玄一、川辺一郎、大見忠弘、「ICPスペクトロメトリーによる薬液中極微量不純物の評価」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 13、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.169-183、1991年7月。
- 293(M) 大見忠弘、「低エネルギーイオン照射薄膜成長」、学術月報 Vol.44、No.7、通巻第559号、(日本学術振興会)、pp.714、1991年7月。
- 294-1(F) 大見忠弘、柴田直、「ウルトラクリーン化技術」、電気学会論文誌A 基礎・材料・共通部門誌、111巻7号、((社)電気学会)、pp.612-617、1991年7月。
- 294-2(M) 大見忠弘、中村雅一、「ガス供給系クリーンテクノロジーの展望」、セミコンダクターアニュアル(ガス供給編)ガスメディア臨時増刊、(テス出版株)、pp.10-14、1991年7月。
- 295(C) 松浦孝、室田淳一、大見忠弘、小野昭一、「高潔淨ECRプラズマによる基板非加熱Si選択エピタキシャル成長」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91、No.205、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-81、pp.7-12、1991年8月。
- 296(C) 島田久幸、広瀬浩一、下村茂樹、小野寺政信、大見忠弘、「界面活性剤添加によるフォトレジスト現像工程の最適化」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91、No.205、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-83、pp.19-24、1991年8月。
- 297(C) 今岡孝之、杉山勇、毛塚健彦、大見忠弘、「液中金属不純物のシリコン表面における偏析現象」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91、No.205、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-85、pp.19-24、1991年8月。

- 298(C) 山下毅雄、羽坂智、名取巖、福井洋文、大見忠弘、「プラズマパラメータ抽出法によるRIEダメージ及びコンタミネーションの制御」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91、No.206、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-95、pp.39-44、1991年8月。
- 203-2(B) 大見忠弘、「半導体技術を革新する新しいフッ素化学」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、フッ素化学、(リアライズ社)、pp.3-4、1991年8月。
- 205-2(B) 菊山裕久、川辺一郎、坂喜代憲、三木正博、大見忠弘、宮下雅之、高野順、「バッファードフッ酸」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、フッ素化学、(リアライズ社)、pp.33-61、1991年8月。
- 206-2(B) 川辺一郎、宮下雅之、大見忠弘、菊山裕久、三木正博、「HFガスによる自然酸化膜の選択除去」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、フッ素化学、(リアライズ社)、pp.65-82、1991年8月。
- 208-2(B) 千葉和郎、三笠和、松下弘、前野又五郎、泉浩人、三木正博、大見忠弘、「F₂を用いた金属表面のフッ化処理ーアルミニウム合金のフッ化処理ー」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、フッ素化学、(リアライズ社)、pp.113-132、1991年8月。
- 299(M) 大見忠弘、宮下雅之、「ウェーハ表面のサブnmの凹凸がMOS特性を左右ー平坦なほど絶縁耐圧や移動度が上がることを定量化ー」、日経マイクロデバイス 1991年9月号、No.75、(日経BP社)、pp.99-105、1991年9月。
- 300(M) 大見忠弘、柴田直、「半導体産業とウルトラクリーンテクノロジー」、空気清浄 1991 第29巻第3号、(日本空気清浄協会)、pp.1-9、1991年9月。
- 301(M) 大見忠弘、柴田直、「半導体製造のためのウルトラクリーン化技術」、精密工学会誌 第681号 Vol.57、No.9、((社)精密工学会)、pp.11-15、1991年9月。
- 302(B) 大見忠弘、森田瑞穂、「ウルトラクリーンテクノロジー」、先端真空利用技術、(日経技術図書株)、pp.478-489、1991年9月。
- 303(M) 桑原英司、斎藤悟、宮脇守、柴田直、大見忠弘、「ウルトラクリーン、低エネルギーバイアススパッタプロセスによるAl配線形成技術」、電気化学および工業物理化学 Vol.59、No.9、((社)電気化学協会)、pp.786-790、1991年9月。
- 304(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.13 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 13、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-4、1991年10月。
- 305(C) 菅野洋一、内沢修、畑山忠弘、大見忠弘、「超小型科化ガス供給システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 13、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.47-88、1991年10月。
- 306(M) 大見忠弘、「半導体エレクトロニクスの将来」、セラミックス、第26巻、第10号、((社)日本セラミックス協会)、pp.1067-1070、1991年10月。
- 307(C) 下西聡、加藤義之、右田智裕、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「極浅n⁺p接合形成のためのイオン注入装置内金属スパッタリング汚染の低減」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.91、No.303、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM91-129、pp.49-54、1991年10月。
- 308(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.14 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 14、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1991年10月。
- 309(C) 下西聡、加藤義之、大見忠弘、「ULSIプロセス低温化のための超高清浄イオン注入技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 14、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.221-235、1991年10月。
- 310(C) 大見忠弘、「Si-SiO₂ 界面構造のデバイス特性への効果」、Si-SiO₂ 界面構造に関する公開シンポジウム、(武蔵工業大学)、pp.4-21、1991年10月。

- 290-2(C) 大見忠弘、「高性能分析評価技術の重要性」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.4、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-4、1991年10月。
- 311-1(M) 大見忠弘、「第二ラウンドを迎えたマイクロエレクトロニクス革命」、ブレインズ '91・生存のための科学、(ブレインズ事務局)、pp.132-135、1991年10月。
- 311-2(C) 森田瑞穂、大見忠弘、「ULSI製造のためのウルトラクリーンプロセス」、EDD-91-41、SPC-91-41、電子デバイス・半導体電力変換合同研究会資料、((社)電気学会)、pp.27-33、1991年10月。
- 292-2(F) 三木正博、大見忠弘、「ICPスペクトロメトリーによる薬液中極微量不純物の評価」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.4、(半導体基盤技術研究会)、pp.20-26、1991年10月。
- 238-2(B) 大見忠弘、柴田直、「Advanced Semiconductor Manufacturing Line」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.3-46、1991年11月。(英文)
- 239-2(B) 桑原英司、宮脇守、大見忠弘、「自然酸化膜フリープロセス」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.49-67、1991年11月。
- 240-2(B) 後藤陽宏、佐々木真、大見忠弘、「プラズマダメージ・チャンバー材料汚染をなくしたプラズマプロセス装置」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.71-94、1991年11月。
- 241-2(B) 浦野智秋、大見忠弘、柴田直、「半導体プロセス装置用排気システム」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.97-112、1991年11月。
- 242-2(B) 小野寺政信、野仲徹、堀越基伸、横田晃、新田雄久、大見忠弘、「アウトガスフリーホトレジストプロセス」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.115-132、1991年11月。
- 243-2(B) 泊里治夫、浜田汎史、仲原善行、杉山和彦、大見忠弘、「半導体製造装置のための金属表面パッシベーションー酸化パッシベーションー」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.135-152、1991年11月。
- 245-2(B) 中村雅一、大見忠弘、川田幸司、大木厚志、日置晃、「高純度ガス供給用オールメタル酸化不動態配管技術」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.175-196、1991年11月。
- 246-3(B) 伊藤一男、大見忠弘、「半導体製造装置用ゲートバルブーウルトラクリーンテクノロジーを適用したオールメタルゲートバルブー」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.199-207、1991年11月。
- 247-3(B) 林雄造、大見忠弘、「半導体製造装置用ゲートバルブー無摺動ゲートバルブの開発ー」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.208-219、1991年11月。
- 312(B) 小野田亨、宍戸昌広、都田昌之、大見忠弘、菅野洋一、梅田優、「超高純度N₂によるWafer気流搬送システム」、大見忠弘・新田雄久監修、半導体基盤技術研究会編、半導体製造におけるクローズドシステム、(リアライズ社)、pp.255-283、1991年11月。
- 313(C) 大見忠弘、「Si表面のマイクロラフネスのデバイス特性への影響」、応用電子物性分科会研究報告No.441、((社)応用物理学会)、pp.5-10、1991年11月。
- 314(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.15序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 15、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-5、1991年11月。
- 315(C) 大木厚志、中村雅一、川田幸司、大見忠弘、「HCl、SiH₄、Si₂H₆ガス中の水分濃度測定」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No. 15、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.73-83、1991年11月。

- 316(C) 大見忠弘、中村雅一、大木厚志、川田幸司、平尾圭志、渡邊剛、「 SiH_4 および Si_2H_6 などの熱分解特性と残留水分および酸素の影響」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 15、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.125-156、1991年11月。
- 317(C) 中村雅一、大木厚志、川田幸司、平尾圭志、渡邊剛、大見忠弘、「 CF_4 ならびに C_2F_6 の熱分解特性と残留水分および酸素の影響」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 15、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.159-166、1991年11月。
- 318(M) 稲葉仁、阪田総一郎、九嶋哲哉、吉田隆紀、岡田孝夫、相合征一郎、大見忠弘、「ウェット工程における静電気対策と空气中不純物汚染の防止」、高砂熱学工業総合研究所報、(高砂熱学工業総合研究所)、pp.35-43、1991年11月。
- 319(M) 大見忠弘、「マイクロエレクトロニクスを担う「半導体革命」で人工知能いよいよ本番」、21世紀への日本・全予兆、(榊学習研究社)、pp.260-262、1991年12月。
- 320(C) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.16序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 16、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1991年12月。
- 321(C) 大見忠弘、「UCT製品の生産現場への適用の必要性」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 16、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1991年12月。
- 322-1(M) 大見忠弘、「シリコン結晶材料とデバイス性能」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.3、No.5、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1991年12月。
- 322-2(M) 大見忠弘、田中信義、御手洗肇、相沢紘、中村佳夫、「増幅型新固体撮像素子の開発と実用化」、大河内賞受賞業績報告書 平成2年度〔第37回〕、((財)大河内記念会)、pp.46-58、1991年12月。
- 323(W) 大見忠弘、中村雅一、大木厚志、川田幸司、平尾圭志、渡邊剛、「特殊材料ガスの熱分解特性」、第1回マイクロエレクトロニクス研究会(大見研究室年次研究討論会)プロシーディング、pp.175-198、1991年12月。